



# 薄膜x線回折・散乱技術入門と SPring-8での利用事例紹介

(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI)

産業利用推進室 産業利用支援グループ 材料構造解析チーム 小金澤 智之

(BL46XU・BL19B2 X線回折計担当)











## 参考文献(X線回折、薄膜X線回折、X線反射率)



- ・リガクジャーナル(要会員登録)
- "Introduction to Advanced X-ray Diffraction Techniques for Polymeric Thin Films". Coatings 2016, 6, 54







## 1、薄膜x線回折・散乱技術入門

## 2、 SPring-8での利用事例紹介





### X線回折



相同定、結晶性・配向性評価、応力・歪み評価、その場観察





### 単結晶x線回折 & 粉末x線回折



放射光施設には専用のビームラインがあり、測定自動化が進んでいる。

単結晶X線回折⇒タンパク質結晶構造解析ビームライン(PF) 構造生物学ビームライン(SPring-8)





### 薄膜X線回折



0次元検出器



20190128 第2回シンクロトロン光産業利用セミナー(愛知)

2次元検出器(1次元検出器)





### 薄膜X線回折(SPring-8 BL46XU, BL19B2)

- 有機薄膜・・・有機薄膜太陽電池、有機ペロブスカイト太陽電池 有機薄膜トランジスタ、有機EL 液晶配向膜
- 無機薄膜・・・金属、半導体、酸化物 太陽電池、トランジスタ【活性層、絶縁膜、電極、保護膜】 磁性薄膜、強誘電体薄膜、



+ 作製プロセスや使用環境を再現したその場薄膜X線回折 【加熱、冷却、真空蒸着、塗布乾燥、光照射、電圧印加、電気化学反応】





### 薄膜X線回折の特徴

- 最適な測定条件を選択 ・試料形状が多種多様 ・基板が存在する、多層である。 ・面外 (膜厚方向)or 面内 ・結晶性、配向性の幅が広い ・入射角が変数
- 3 · 0 or 2次元検出器

X線エネルギー ビームサイズ 検出器 測定領域 測定時間 測定方向、測定方法

### 事前検討、事前相談が大切

- ・膜厚が薄い(100 nm以下)
- ・結晶性が低い



放射光(高輝度x線) が有効





### ①結晶性・配向性







### 1結晶性・配向性とx線回折パターン





ガラス基板





CeO<sub>2</sub>/ガラス基板





### ①結晶性・配向性とX線回折パターン

1軸配向





### 高分子スピンコート膜/ITO基板







### ①結晶性・配向性とX線回折パターン

### 3軸配向(流動配向、エピタキシャル膜)



試料法線方向(φ軸)を回転軸 360°連続回転中に1800枚撮影(0.2°刻み) 測定時間15分(1枚0.5秒)





Annealed Ti/SiC





### ①結晶性・配向性







### 2入射角

微小角入射X線回折(散乱) 斜入射X線回折(散乱) すれすれ入射X線回折(散乱) GIXD : Grazing incidence X-ray diffraction GIWAXS : GI wide angle X-ray scattering GI-XRD : GI X-ray diffraction







2入射角











SPring 8 ③ スリット+0次元検出器 or 2次元検出器











### Au / Si基板

入射角 θ = 0.2 °









フットプリントの影響



#### 入射角依存性

$\theta = 0.6^{\circ}$	$\theta = 2.0^{\circ}$	$\theta = 5.0^{\circ}$





### 薄膜X線回折の特徴





・入射x線強度・回折能(結晶性)・Bragg条件を満たしているか ・回折線の方向に検出器があること

良い実験をするには ①<u>ご自身のサンプル</u>②<u>得たい情報(捨てて良い情報)</u>③<u>測定手法の特徴④装置の特徴</u> を把握することが重要です。







## 1、薄膜x線回折・散乱技術入門

# 2、 SPring-8での利用事例紹介





## SPring-8 運転・利用状況

- 共用ビームライン:26本 理研ビームライン: 9本 専用ビームライン:19本
- (JASRIが管理・運営)
- 原子力機構、QST、物質材料機構、兵庫県 東大、阪大、京大、電通大 企業コンソーシアム、豊田 台湾

- 運転時間 : 5000時間、200日運転
- ユーザー利用:4200時間
- 課題数 :1000課題
- 年間利用者 :約10000人
  - 大学・公的研究所: 80% 企業 : 20%





SPring-8 ビームラインマップ







## JASRI産業利用推進室が運営するBL

Beamline	B/U	Mono.	E range	techniques
BL14B2	偏向電磁石	水冷二結晶分光器	3.8-72 keV	①XAFS ②X線イメージング
BL19B2	偏向電磁石	水冷二結晶分光器	5-72 keV	①粉末X線回折計 ② <mark>多軸X線回折計</mark> ③小角・超小角散乱
BL46XU	アンジュ レーター	液体窒素冷却 二結晶分光器	6-35 keV	① <u>多軸X線回折計</u> ②硬X線光電子分光 ③X線イメージング

産業界からニーズの高い硬x線領域の測定手法を整備 BL19B2とBL46XUの多軸x線回折計で薄膜x線回折を受入れ



ビームラインの特徴



### BL14B2(產業利用II)







## BL19B2(産業利用I)



#### 3つの実験ハッチで提供される多様な放射光利用技術を特徴とする

#### ビームラインの特徴

BL19B2は、偏光電磁石を光源とする全長約120mの中尺ビームラインで、3つの実験ハッチを 持ち、4種類)の実験装置を用意することによって、産業界の多様な分野に対応できることを 特徴としております。その実験技術は測定の自動化等、高効率化を進めることによって実現 した測定代行などコストパフォーマンスの高い利用から、極小角x線散乱のようにここでしか 得られない情報が得られる特徴的な実験技術の利用まで、多様なニーズにもこたえられるよ うな利用技術開発を行っています。



- 1. 多軸X線回折計
- 2. 粉末X線回折
- 3. 小角・極小角×線散乱
- 4. X線イメージング







## BL46XU (産業利用Ⅲ)の概要

#### 第1実験ハッチ



第2実験ハッチ



<u>利用可能X線エネルギー</u>: 6-35 keV





## **Overview of BL46XU**







## 硬X線光電子分光(HAXPES)

### 第2実験ハッチ







### HAXPESの特徴



### 検出深度大(ラボの数倍)

- Bulk sensitive (surface insensitive)
- Low surface/contaminant effects (surface preparation is less important)
- Analysis of buried interfaces
- Depth profiling by TOA dep.





### HAXPESの特徴



#### Table. Binding energy for photoelectron (eV) ラボXPS 2s 2p1/2 2p3/2 3s 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 Li ラボXPSのAl Kα線励起で測定 1.5 keV以下ではピークが密集 543 697 可能な光電子ピーク 73 →他のピークと重畳しやすい 2472 2822 3206 3608 4039 4492 4966 5465 5989 6539 7112 7709 8333 s軌道以外はピーク分裂で解析困難 • 454 769 650 639 793 10367 1143 100 **HAXPES** 161 182 12658 13474 1474 1596 1731 1864 2007 2465 2793 2967 2156 2007 2465 2793 3524 3330 3524 3330 3524 3330 3524 33938 4156 4380 4612 5107 5359 5624 55891 6164 40 6722 7013 7312 8058 7617 7930 82521 167 189 257 69 94 112 1678 15200 16105 327 359 249 280 311 344 484 484 521 560 604 653 703 757 813 239 270 299 330 361 394 418 461 497 532 573 1940 17998 18986 2223 2371 2520 2677 2838 181 205 231 258 284 312 179 202 228 254 280 307 共存元素の内殻やオージェ, プラズ • 21044 22117 モンロス等のピークの重畳を回避で 3173 3351 25514 374 368 405 444 485 528 573 619 676 727 781 836 884 929 980 27940 29200 30491 31814 33169 34561 35985 37441 38925 3730 3929 4132 665 715 766 820 875 941 きる 493 538 137 153 4557 1072 186 213 931 1002 1071 1137 1209 1274 1337 1403 631 689 741 796 853 902 146 5012 1211 179 196 207 218 225 1128 1187 1242 1297 1362 1436 5483 5723 275 291 ピーク分裂がなく解析が容易な深い 41991 43569 236 243 1003 6208 1575 319 121 121 120 129 128 143 46834 49519 50239 247 257 271 6716 6977 7243 7514 7790 8071 1541 1614 1688 1768 1842 1923 2006 2090 2173 2264 2365 2469 2575 2682 2792 2909 3027 3148 3279 266 284 322 334 346 386 386 389 412 438 463 1s準位を使える(Al 1s: 1.65 keV, Si -347 1800 1881 1968 2047 2128 2207 2307 2398 2491 2601 2708 2820 2932 3049 3174 1481 1544 1159 1128 379 53789 9046 1293 414 154 160 1676 1741 1812 1885 1950 2024 2108 2194 2281 2367 2457 2551 2645 2743 1333 293 308 320 333 340 359 381 401 424 447 471 1s: 1.84 keV) 1409 471 481 507 1576 1639 1716 1793 61332 10486 8944 9244 1528 1589 1662 1735 9978 9881 563 238 HAXPES(8 keV)で測定可能となる 519 549 578 10535 1949 1883 2040 2122 2206 2295 296 315 335 359 2116 519 546 577 3425 3562 2291 2385 762 643 光電子ピーク







~HAXPESの特徴~

- ・検出深度が大きい→非破壊で試料深部(界面、バルク)の状態分析ができる。
- ・測定可能なピークが多い→ピーク同士の重畳の回避や解析の行いやすいピークが選択できる。





## HUBER社多軸X線回折計



- ・**x線エネルギー** : 6-35 keV 72KeV@三倍波
- ・X線ビームサイズ : 3 um 1 mm
- ・X線ビーム強度 : 最大10<sup>13</sup> photons/sec
  - アッテネータで減衰

・試料周辺

・位置調整用自動ステージ:xyz、スイベル、 ・試料環境 :大気、He雰囲気、加熱、

・**検出器**:角度分解能・観測エリア・測定時間

- ・0次元検出器(+スリット光学系)
- 1次元検出器
- 2次元検出器

幅広い測定ニーズに応えられるように測定環境整備

ご相談いただき、スタッフが最適な条件を提案





## 多軸X線回折計:検出器



double slits + 0D detector



crystal analyzer+ 0D detector



#### 2D detector (PILATUS 300K)



sollar slits + 0D detector



1D detector( 6 modules of MYTEHN)

装置セットアップはスタッフが実施



2D detector (PILATUS 2M)





## 多軸X線回折計:試料周辺



大気中、複数試料



加熱、anton parr DHS1100



真空蒸着、基板冷却、TFT測定 岩手大学吉本先生



カプトンドーム He、N,雰囲気



溶媒雰囲気制御+UV-Vis

産総研宮寺先生









## オープンスペースの利用













### ハイブリッド検出システム

#### 2台の独立駆動検出器軸 2治の独立駆動検出器軸 光学系+0次元検出器







## organic semiconductor





### Characterization of OPVs







#### Effect of additional alkyl groups

I. Osaka, et al., J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 8834-8837





ミストCVD法で製膜したSnO<sub>2</sub>/YSZ エピタキシャル膜の結晶構造評価

SPring. 8

#### 京都大学 菅先生、島川先生

Journal of Applied Physics 124, 125303 (2018)







### X線反射率







### X線反射率で得られる情報







### 微小部X線反射率測定







## SPring-8共用ビームライン課題申請(産業利用BL)

	○一般課題(産業利用分野)	年6回募集	
	○放射光施設橫断産業利用課題	2019A	<del>2019A1</del>
	○大学院生提案型課題		2019A2 2019A3
	○長期利用課題 【牛Ⅰ凹券集】	2019B	2019B1 2019B2
有償	<ul><li>○成果公開優先利用課題</li><li>○成果専有課題</li></ul>		2019B3
	<ul><li>○時期指定成果専有課題 【随時募集】</li><li>○測定代行 【随時募集】</li></ul>		

研修会「二次元検出器を用いた薄膜x線回折測定研修会」 年1回11 or 12月

ご質問、ご要望がございましたらお気軽にお問い合わせください koganeza@spring8.or.jp





## SPring-8共用ビームライン課題申請

